

2SD1783

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコンダーリントトランジスタ
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
Epitaxial Planar NPN Silicon Darlington Transistor

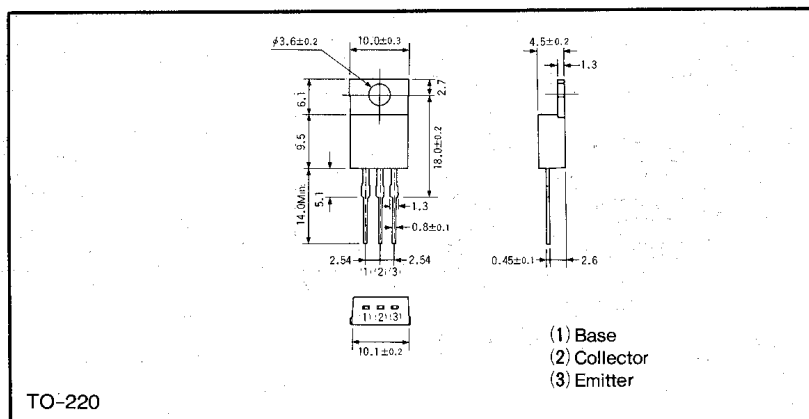
● 特長

- 1) コレクタ・ベース間に60Vのツェナーダイオードを内蔵
- 2) サージに強い。
- 3) ダンパーダイオード内蔵。
- 4) ベース・エミッタ間に抵抗内蔵。

● Features

- 1) Built-in Zener diode of 60V across collector and base.
- 2) Resistant to surge.
- 3) Damper diode is incorporation.
- 4) Built-in resistance across base and emitter.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit: mm)



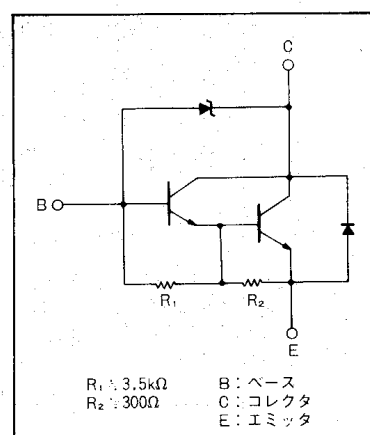
トランジスタ

2SDタイプ

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60±10	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	60±10	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	5	A
		10	A(Pulse)
コレクタ損失	P_C	30	W(Tc=25°C)
		1.5	W(Ta=25°C)
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	°C

● 内部等価回路図



● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	50	—	70	V	$I_C = 5mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	50	—	70	V	$I_C = 50\mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	100	μA	$V_{CB} = 40V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	3	mA	$V_{EB} = 5V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C/I_B = 2A/2mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	2 000	—	30 000	—	$V_{CE}/I_C = 3V/2A$
出力容量	C_{ob}	—	75	—	pF	$V_{CB} = 10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

● 標準品・準標準品一覧表 (◎: 標準品 ○: 準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	トレイ
		記号	Y2
		基本発注単位(個)	200
2SD1783	2K~30K		◎